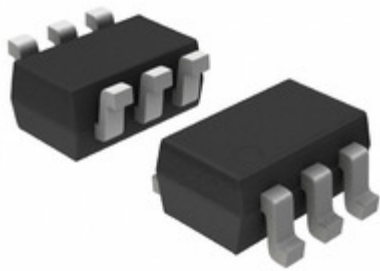



	<h2 style="color: red;">NSBA113EDXV6T1G</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: NSBA113EDXV6T1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT563
	Datenblätter:  NSBA113EDXV6T1G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	NSBA113EDXV6T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT563
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 5mA, 10mA
Transistor-Typ	2 PNP - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	1k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	1k
Leistung - max	250mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	3 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

NSBA113EDXV6T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSBA113EDXV6T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSBA113EDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NSBA113EDXV6T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>NSBA114EDP6T5G ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.338W SOT963</p>	 <p>NSBA114EDXV6T1 ON NSBA114EDXV6T1 ON</p>	 <p>NSBA114EDXV6T1G ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p>NSB9435T1 ON NSB9435T1 ON</p>
 <p>NSB9703 Desco COMMON POINT GND CORD 10MM 10'</p>	 <p>NSB8MTH3_A/P Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>	 <p>NSBA114EDXV6T5 ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p>NSBA113EF3T5G ON Semiconductor TRANS PREBIAS DUAL PNP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSBA113EDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NSBA113EDXV6T1G Datenblatt	NSBA113EDXV6T1G-Datenblätter	NSBA113EDXV6T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSBA113EDXV6T1G
NSBA113EDXV6T1G Electronic	NSBA113EDXV6T1G-Komponenten	NSBA113EDXV6T1G-Verteiler	NSBA113EDXV6T1G-Bild	NSBA113EDXV6T1G-Teil
NSBA113EDXV6T1G Preis	NSBA113EDXV6T1G Hersteller	NSBA113EDXV6T1G Bild	NSBA113EDXV6T1G Aktie	NSBA113EDXV6T1G Inventar
NSBA113EDXV6T1G Neu	NSBA113EDXV6T1G Original	NSBA113EDXV6T1G garantiert	NSBA113EDXV6T1G RFQ	NSBA113EDXV6T1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited